

Cesto Di Pulizia In Ptfе Per Semiconduttori - Portawafers Da 12 Pollici Resistente Agli Acidi E Agli Alkali In Fluoropolimero Per Incisione Umida

Numero articolo: PL-CP81



introduzione

Progettato per ambienti a alta purezza per semiconduttori, questo cesto di pulizia per wafer da 12 pollici in PTFE garantisce un'eccezionale resistenza chimica durante i processi critici di incisione umida e pulizia. Il design su misura offre un supporto affidabile per i wafer e una massima esposizione ai fluidi per la produzione di precisione.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Pulizia RCA	Sequenza standardizzata (SC-1 e SC-2) per la rimozione di contaminanti organici e impurità metalliche.	Impedisce la ricontaminazione durante le transizioni tra pH alto e basso.
Incisione con HF	Rimozione di strati di ossido sacrificale o ossidi nativi utilizzando soluzioni di acido fluoridrico.	L'immunità totale all'attacco dell'HF garantisce una lunga durata dell'apparecchiatura.
Incisione Piranha	Miscelazione ad alta temperatura di acido solforico e perossido di idrogeno per la rimozione del fotoresist.	Resiste a reazioni esotermiche estreme senza ammorbidimento strutturale.
Risciacquo post-CMP	Rimozione di particelle di slurry e sostanze chimiche dopo la lucidatura chimico-meccanica.	Punti di contatto minimi impediscono l'intrappolamento di particelle dietro il wafer.
Texturizzazione per celle solari	Texturizzazione acida o alcalina di wafer di silicio di grande formato per migliorare l'assorbimento della luce.	Durabilità per alti volumi in ambienti con esposizione chimica continua.
Fabbricazione MEMS	Incisione umida profonda di substrati di silicio o vetro per creare strutture micromeccaniche.	Garantisce velocità di incisione uniformi grazie alla circolazione ottimizzata dei fluidi.
Fotolitografia	Sviluppo e stripping di materiali fotoresist utilizzando solventi organici specializzati.	Il materiale resistente ai solventi impedisce la lisciviazione di sostanze organiche nello sviluppatore.
Pulizia megasonica	Pulizia acustica ad alta frequenza per rimuovere particelle submicroniche dalle superfici dei wafer.	La densità del materiale trasmette efficacemente l'energia acustica senza effetti di smorzamento.

Caratteristica	Dettaglio specifiche (PL-CP81)
Materiale principale	PTFE vergine a alta purezza (Politetrafluoroetilene)
Compatibilità diametro wafer	300 mm (12 pollici) - Misure personalizzate disponibili su richiesta
Configurazione	Portawafers per wafer singolo / Configurazione a cestino per più wafer
Processo di fabbricazione	Lavorazione CNC di precisione / Fabbricazione su misura
Resistenza chimica	Gamma completa (pH 0-14); resistente a HF, HNO ₃ , HCl, H ₂ SO ₄ , KOH, ecc.
Temperatura di esercizio	Uso continuo fino a 260°C (Limiti personalizzati in base al progetto)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Caratteristica	Dettaglio specifiche (PL-CP81)	
Passo / Spaziatura slot	Completamente personalizzabile per soddisfare i requisiti di flusso di fluido o capacità	
Tipo di contatto	Disponibili design a contatto puntuale o a contatto laterale	
Opzioni maniglia	Interfaccia a flangia fissa, rimovibile o robotica automatizzata	
Finitura superficiale	Finitura lavorata ultra-liscia per minimizzare l'adesione di particelle	
Standard di purezza	Conforme ai standard per semiconduttori; analisi dei metalli in tracce disponibile	